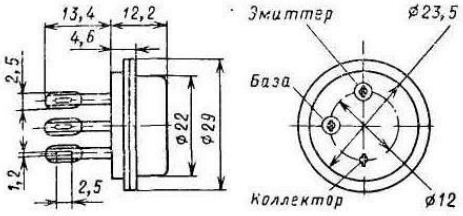
1Т806А, 1Т806Б, 1Т806В, ГТ806А, ГТ806Б, ГТ806В, ГТ806Г, ГТ806Д

Транзисторы германиевые диффузионно-сплавные *p-n-p* переключательные низкочастотные мощные

Предназначены для работы в импульсных схемах, преобразователях и стабилизаторах тока и напряжения

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с жесткими выводами. Обозначение типа приводится на корпусе.

Масса транзистора не более 28 г



Электрические параметры

Граничное напряжение при $I_Э = 3$ А, $\tau_и \leqslant 50$ мкс, $f = 20 \div 50$ Гц не менее
- 1Т806А . . . . . 40 В
- 1Т806Б . . . . . 65 В
- 1Т806В . . . . . 80 В

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер не более
- при $I_К = 20$ А, $I_Б = 2$ А 1Т806А, 1Т806Б, 1Т806В . . 0,6 В
- при $I_К = 15$ А, $I_Б = 2$ А ГТ806А, ГТ806Б, ГТ806В, ГТ806Г, ГТ806Д . . . . . 0,6 В

Напряжение насыщения база-эмиттер не более
- при $I_К = 20$ А, $I_Б = 2$ А 1Т806А, 1Т806Б, 1Т806В . . . 0,8 В
- при $I_К = 15$ А, $I_Б = 2$ А ГТ806А, ГТ806Б, ГТ806В, ГТ806Г, ГТ806Д . . . . . 1,0 В

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером (на границе насыщения)

1Т806А, 1Т806Б, 1Т806В.
- при $T_к = 298$ К, $I_К = 10$ А . . . . . 10 – 100
- при $T_к = 343$ К, $I_К = 5$ А . . . . . 10 – 100
- при $T = 213$ К, $I_К = 10$ А . . . . . 10 – 150

ГТ806А, ГТ806Б, ГТ806В, ГТ806Г, ГТ806Д:
- при $T_к = 298$ К, $I_К = 10$ А . . . . . 10 – 100
- при $T_к = 328$ К, $T_К = 5$ А . . . . . 10 – 200
- при $T = 218$ К, $I_К = 10$ А . . . . . 8 – 100

Время выключения при $U_{КЭ} = 45$ В, $I_К = 5$ А, $I_Б = 0,25$ А не более . . . . . 30 мкс

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КЭ} = 5$ В, $I_К = 1$ А не менее . . . . . 10 МГц

Обратный ток коллектор-эмиттер при $U_{БЭ} = 1$ В, $U_{КЭ} = 75$ В 1Т806А; при $U_{КЭ} = 100$ В 1Т806Б, при $U_{КЭ} = 120$ В 1Т806В не более
- при $T = 298$ К и $T = 213$ К . . . . . 12 мА
- при $T = 343$ К . . . . . 25 мА
- при $T = 298$ К $U_{КЭ} = U_{КЭ\ макс}$ ГТ806А, ГТ806Б, ГТ806В, ГТ806Г ГТ806Д . . . . . 15 мА

Обратный ток эмиттера не более
- при $U_{БЭ} = 2$ В 1Т806А, 1Т806Б 1Т806В . . . . 5 мА
- при $U_{БЭ} = 1,5$ В ГТ806А, ГТ806Б, ГТ806В ГТ806Г, ГТ806Д . . . . . 8 мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $U_{БЭ} = 1$ В
- 1Т806А, ГТ806А . . . . . 75 В
- 1Т806Б, ГТ806Б . . . . . 100 В
- 1Т806В, 1Т806В . . . . . 120 В
- ГТ806Г . . . . . 50 В
- ГТ806Д . . . . . 140 В

Постоянное напряжение база-эмиттер
- 1Т806А, 1Т806Б, 1Т806В . . . . . 2 В
- ГТ806А, ГТ806Б, ГТ806В, ГТ806Г, ГТ806Д . . . 1,5 В

Постоянный ток коллектора в режиме насыщения
- 1Т806А, 1Т806Б, 1Т806В . . . . . 20 А
- ГТ806А, ГТ806Б, ГТ806В, ГТ806Г ГТ806Д . . . . 15 А

Импульсный ток коллектора в режиме насыщения при $Q \geqslant 2$, $\tau_и = 1000$ мкс, $K_{нас} = 1$ 1Т806А 1Т806Б, 1Т806В 25 А

Постоянный ток базы . . . . . 3 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора
- с теплоотводом при $T_к \leqslant 298$ К . . . . . 30 Вт
- без теплоотвода при $T \leqslant 298$ К . . . . . 2 Вт

Тепловое сопротивление переход-корпус . . . . . 2 К/Вт

Тепловое сопротивление переход-среда . . . . . 30 К/Вт

Температура перехода . . . . . 358 К

Температура окружающей среды
- 1Т806А, 1Т806Б, 1Т806В . . . . . От 213 до $T_к = 343$ К
- ГТ806А ГТ806Б, ГТ806В, ГТ806Г, ГТ806Д . . От 218 до $T_к = 328$ К

Примечания 1 При $T_к = 298 - 343$ К (при $T_к = 328$ К ГТ806А, ГТ806Б, ГТ806В, ГТ806Г, ГТ806Д) максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора, Вт, с теплоотводом рассчитывается по формуле

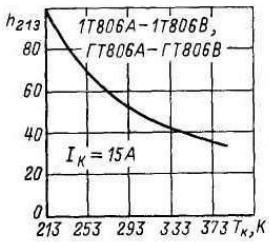
$$P_{К\ макс} = (358 - T_к)/R_{T\ п\text{-}к}$$

Не допускается отключение базы при наличии напряжения между коллектором и эмиттером Не рекомендуется работа транзистора при рабочих токах, соизмеримых с неуправляемыми токами во всем диапазоне температур

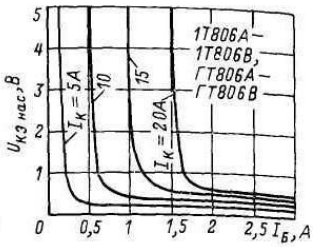
Эксплуатация транзисторов в режимах за пределами областей максимальных режимов, в том числе с учетом процессов, происходящих при включении и выключении, запрещается При работе в импульсном режиме при отсутствии открывающего импульса транзистор должен быть закрыт положительным смещением базы $0,5\ В \leqslant U_{БЭ} \leqslant 2$ В

2. Пайка выводов допускается на расстоянии не менее 6 мм от корпуса транзистора. При включении транзистора в электрическую цепь, находящуюся под напряжением, коллекторный контакт должен подсоединяться последним и отсоединяться первым

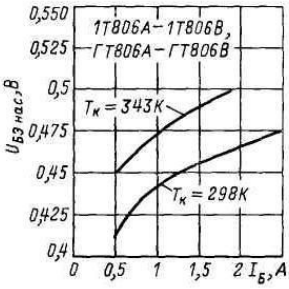
www.alltransistors.com



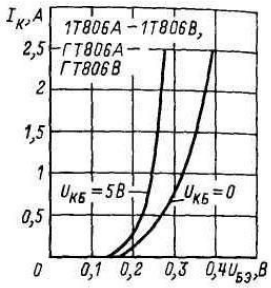
Зависимость статического коэффициента передачи тока от температуры корпуса



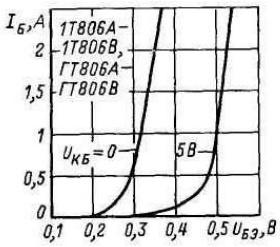
Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от тока базы



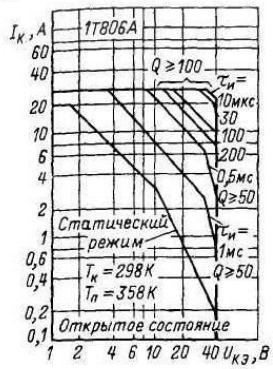
Зависимость напряжения насыщения база-эмиттер от тока базы



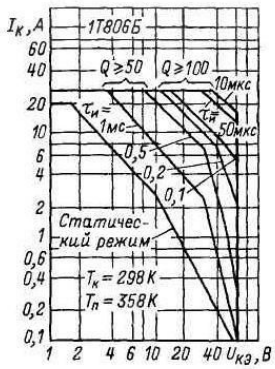
Зависимость тока коллектора от напряжения база-эмиттер



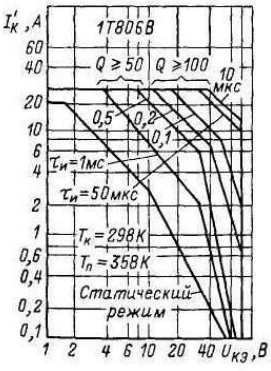
Входные характеристики.



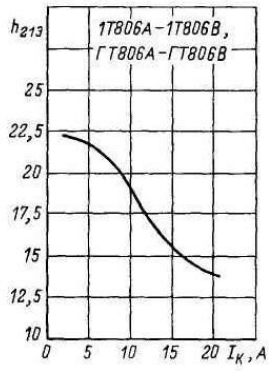
Область максимальных режимов.



Область максимальных режимов



Область максимальных режимов.



Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока коллектора.

http://alltransistors.com